

委員各位

日本学術振興会ワイドギャップ半導体  
光・電子デバイス第 162 委員会  
委員長 吉川 明彦

日本学術振興会ワイドギャップ半導体光・電子デバイス第 162 委員会  
第 71 回委員会・第 75 回研究会 開催案内

日時：平成 23 年 7 月 22 日（金）

委員会：12：00 - 13：00

研究会：13：00 - 17：40

場所：キャンパス・イノベーションセンター東京（田町駅前）1 階国際会議室

URL：http://www.cictokyo.jp/

〒108-0023 東京都港区芝浦 30-3-6 TEL:03-5440-9020

### 委員会

議題：

- (1) 前回第 70 回委員会議事録承認について
- (2) 学振第 162 委員会 平成 22 年度決算・平成 23 年度予算案について
- (2) 委員の異動について
- (3) 次回第 76 研究会（10 月）およびそれ以降の研究会について
- (4) その他

報告事項：

- (1) APWS-2011 について
- (2) 「技術の伝承等成果とりまとめ刊行」に関する出版について
- (3) その他

**研究会** 主 題：「InGaN エピタキシーの基礎 - 如何に In を取り込むか -」

委員長挨拶・企画趣旨説明（13:00-13:10）

1. 「InN 系窒化物のエピタキシー制御・物性制御・ナノ構造制御の現状と展望 - 表面ストイキオメトリ制御から、pn 接合形成まで -」（13:10-14:00）

千葉大学大学院工学研究科<sup>1</sup>、G-COE<sup>2</sup>、VBL<sup>3</sup>、JST-ALCA:SMART Solar Cell PJ<sup>4</sup>

吉川 明彦<sup>1,2,3,4</sup>、王 新強<sup>1,#1</sup>、崔 成伯<sup>1,3,#2</sup>、石谷 善博<sup>1,3,4</sup>、橋本 直樹<sup>1,3,4</sup>、徐 科<sup>1,3,#3</sup>、

草部 一秀<sup>1,2,3,4</sup>（現在の所属：#1：北京大学、#2：パナソニック株、#3：中国科学アカデミー）

2. 「加圧 MOVPE 及び窒素ラジカル MBE を用いた高 In 組成 InGaN 成長」（14:00-14:50）

名古屋大学大学院工学研究科、赤崎記念研究センター 天野 浩、大畑 俊也、田畑 拓也、  
坂倉 誠也、谷川 智之、河合 洋次郎、本田 善央、山口 雅史

3. 「DERI 法による In 系窒化物半導体の結晶成長」（14:50-15:40）

工学院大学工学部<sup>1</sup>、立命館大学理工学部<sup>2</sup>、ソウル国立大学<sup>3</sup> 山口 智広<sup>1,2</sup>、荒木 努<sup>2</sup>、  
本田 徹<sup>1</sup>、名西 愷之<sup>2,3</sup>

休憩（15:40-16:00）

4. 「MOVPE 成長 InGaN 系 LED の長波長化」（16:00-16:50）

東京理科大学応用物理学科 大川 和宏

5. 「原料分子制御法を用いた AlN, GaN, InN および InGaN の HVPE」 (16:50-17:40)

東京農工大学工学研究院 額額 明伯、熊谷 義直、村上 尚

---

<追記>

1. 委員会では昼食を用意いたします。
2. 弁当準備の都合等があるため、委員会・研究会の出欠を7月11日(月)までに日本学術振興会研究事業課 檜崎 様 (jigyouka09@jsps.go.jp) まで、必ずご連絡くださいますようお願いいたします。